

Rohm[®]
QUALITY · RELIABILITY



PNP
type

トランジスタ

PNP エピタキシャルプレーナ型

シリコントランジスタ

低周波増幅用

■ 絶対最大定格 (Ta=25°C) (Absolute Maximum Ratings)

項目	記号	定格	単位
コレクタ・ベース電圧	2SA785, 2SA825	-80	V
	2SA786, 2SA826	-50	
コレクタ・エミッタ電圧	2SA785, 2SA825	-80	V
	2SA786, 2SA826	-40	
エミッタ・ベース電圧	VEBO	-5	V
コレクタ電流	Ic	-50	mA
コレクタ損失	2SA785, 2SA825	150	mW
	2SA825, 2SA826	250	
接合部温度	Tj	125	°C
保存温度	Tstg	-55~125	°C

■ 電気的特性 (Ta=25°C) (Electrical Characteristics)

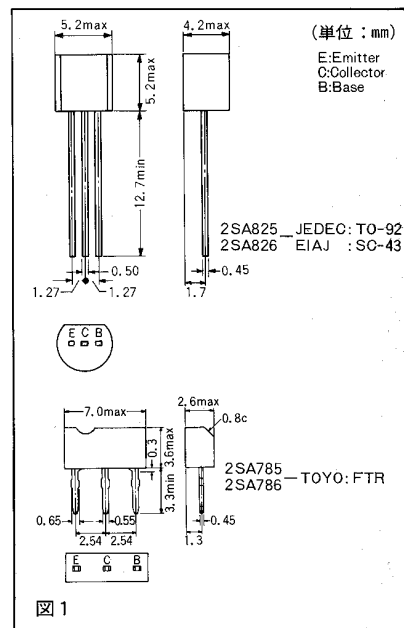
項目	記号	MIN	TYP	MAX	単位	条件
コレクタ・エミッタ 降伏電圧	BV _{CE}	-80	—	—	V	I _c = -1mA, R _{BE} = 10KΩ
コレクタ・ベース 降伏電圧	BV _{CE0}	-40	—	—		I _c = -1mA
コレクタ・ベース 降伏電圧	BV _{CB0}	-80	—	—	V	I _c = -50μA
エミッタ・ベース降伏電圧	BV _{EB0}	-50	—	—		I _E = -50μA
コレクタシャ断電流	I _{CB0}	—	—	-1	μA	V _{CB} = -50V
						V _{CB} = -30V
エミッタシャ断電流	I _{EB0}	—	—	-1	μA	V _{EB} = -4.5V
直流電流増幅率	h _{FE}	82	—	270	—	V _{CE} = -3V, I _c = -10mA
コレクタ・エミッタ飽和電圧	V _{CE(sat)}	—	—	-0.5	V	I _c = -10mA, I _B = -1mA
利得帯域幅積(トランジション周波数)	f _T	—	180	—	MHz	V _{CE} = -5V, I _E = 10mA
コレクタ出力容量	C _{ob}	—	6.5	—	pF	V _{CB} = -6V, I _E = 0, f = 1MHz

h_{FE}の値により下表のように分類します。

アイテム	P	Q	R
h _{FE}	82~180	120~270	180~390

注) 2SA786および2SA826のh_{FE}範囲は82~390です。

■ 外形寸法図 (Physical Dimension)



2SA785 2SA786
2SA825 2SA826